

# ST03D-82

82V 300W

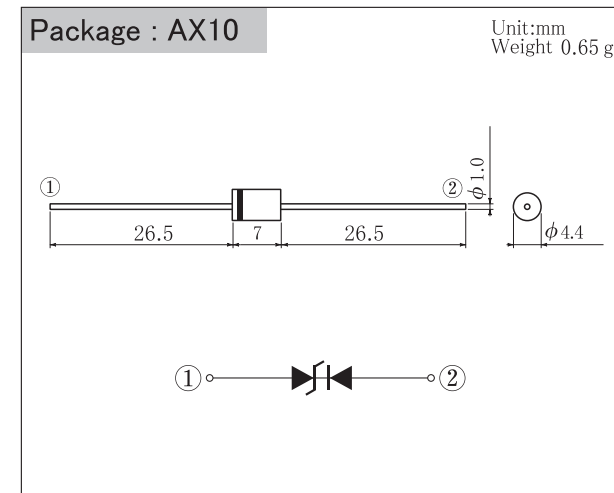
### 特長

- ・パワーツェナーダイオードとFRDを複合
- ・アキシャル型
- ・スナバ回路用途

### Feature

- ・ Power Zener Diodes with FRD
- ・ Axial Package
- ・ Application for snubber circuit

### ■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は(半導体製品一覧表)をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

### ■定格表 RATINGS

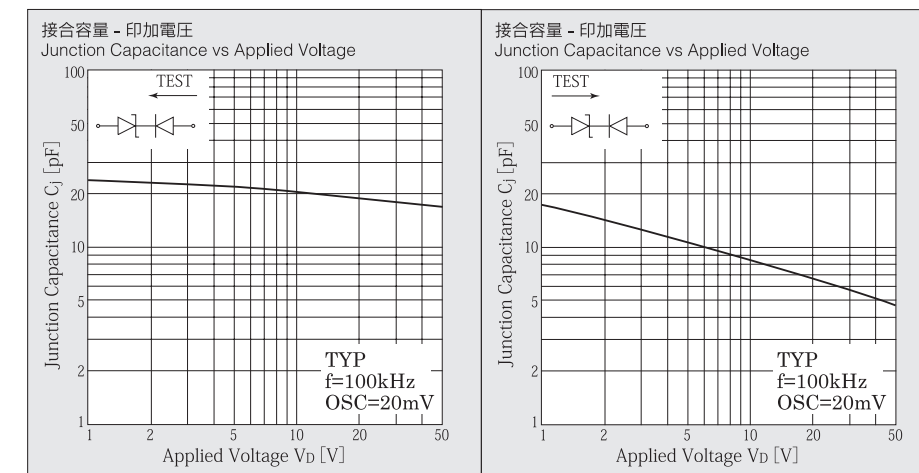
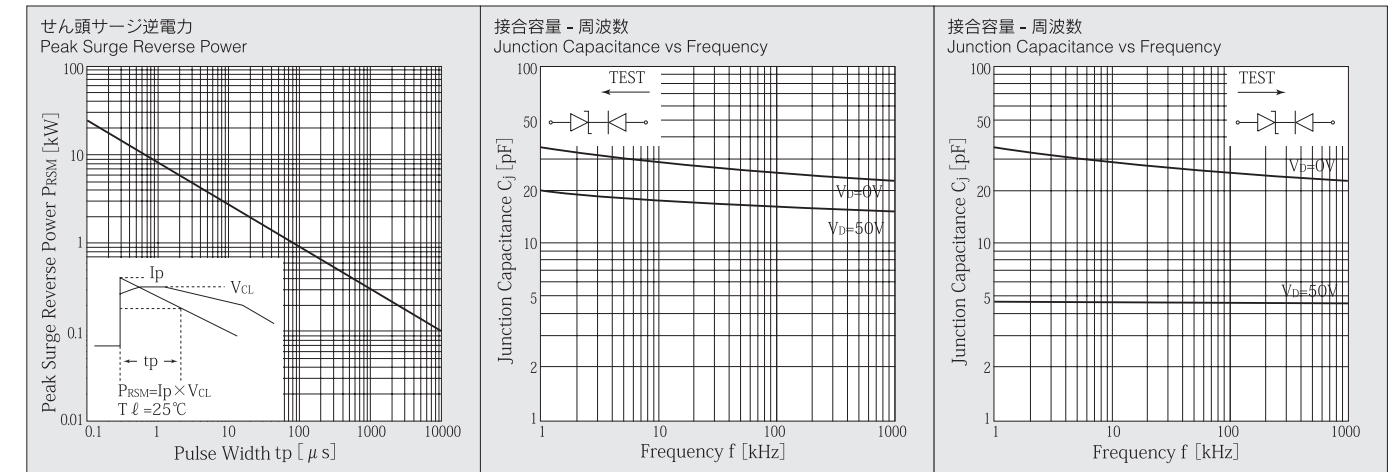
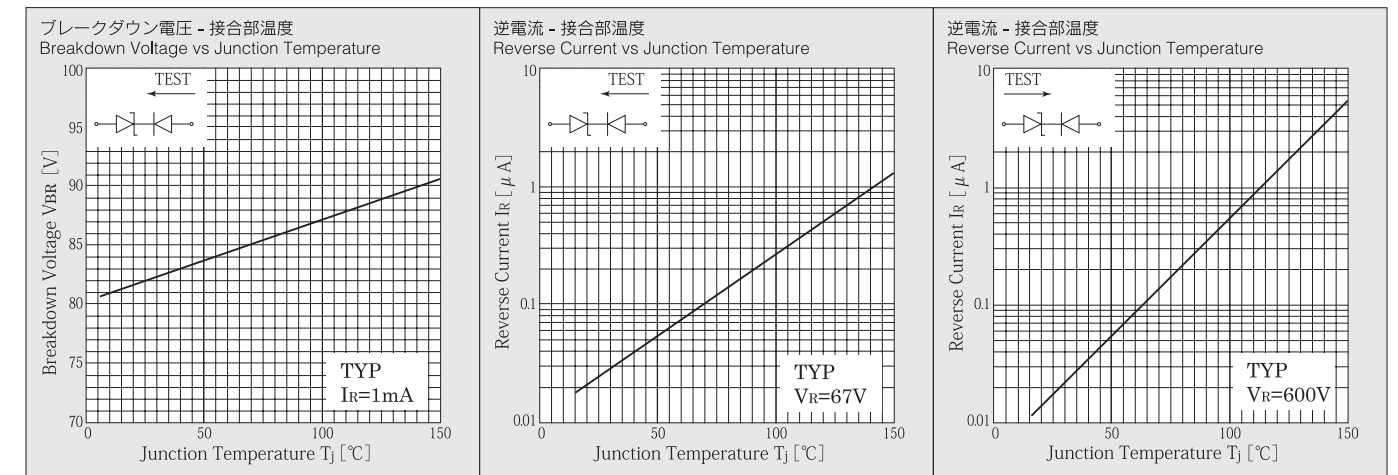
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_1=25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	ZD	Di	単位 Unit
保存温度 Storage temperature	$T_{stg}$		-40~150	-40~150	°C
接合部温度 Operating junction temperature	$T_j$		150	150	°C
せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power	PRSM	10/1000 $\mu\text{s}$ 非繰り返し 10/1000 $\mu\text{s}$ Non-repetitive	300	-	W
せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current	IRSM	10/1000 $\mu\text{s}$ 非繰り返し 10/1000 $\mu\text{s}$ Non-repetitive	2.5	-	A
連続印加電圧 Maximum reverse voltage	VRM		67	600	V

### ●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

動作開始電圧 Breakdown voltage	$V_{BR}$	$I_R=1\text{mA}$	MIN. 74 TYP. 82 MAX. 90	-	V
制限電圧 Restriction voltage	$V_{CL}$	$I_{PR}=2.5\text{A}$	MAX. 118	-	V
逆電流 Reverse current	$I_R$	$V_R=67\text{V}$ $V_R=600\text{V}$	MAX. 5 -	MAX. 5	$\mu\text{A}$
逆回復時間 Reverse recovery time	$t_{rr}$	$I_F / I_R = 0.1\text{A} / 0.3\text{A}$	-	MAX. 500	ns
熱抵抗 Thermal resistance	$\theta_{j1}$	接合部・リード間 junction to lead	MAX. 13		°C/W

### ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\*Sine waveは50Hzで測定しています。  
\*50Hz sine wave is used for measurements.  
\*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
Typicalは統計的な実力を表しています。  
\*Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical a statistical average of the devices ability.